(54) VIBRATIONPROOF MOUNT

(11) 1-91497 (A) (43) 11.4.1989 (19) JP

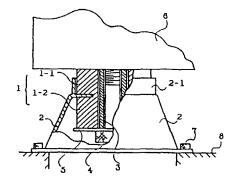
(21) Appl. No. 62-247804 (22) 2.10.1987

(71) HITACHI LTD (72) KUNIHIRO MOTOYOSHI

(51) Int, Cl⁴, H05K5/02

PURPOSE: To obtain a vibrationproof mount having high reliability causing no damage due to separation of bonded parts or cracks in rubber, by adapting the mount such that a vibrationproof rubber body is subjected only to compression load.

CONSTITUTION: If a supported body 6 is vibrated vertically, an upper rubber 1-1 and a lower rubber 1-2 are compressed and deformed alternately to suppress the movement of the supported body 6. Transverse vibration of the supported body 6 is also suppressed by the upper rubber being compressed and deformed between a cylinder 3 and a projection 2-1 of a fixing 2. Accordingly, either vertical or transverse vibration gives the rubber 1 only compression force. As a result, a vibrationproof mount having high reliability causing no damage due to seperation of bonded parts or cracks in the rubber can be obtained.



(54) RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE THEREOF

(11) 1-91498 (A)

(43) 11.4.1989 (19) JP

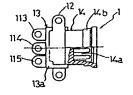
(21) Appl. No. 63-108520 (22) 30.4.1988 (33) JP (31) 87p.142043 (32) 5.6.1987

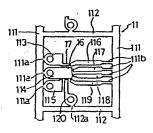
(71) NIPPON DENSO CO LTD (72) KOJI SHIBATA(3)

(51) Int. Cl. H05K7/02,H01L23/28,H01L23/34,H01L23/48,H01R9/16,H02P9/30,H05K5/00

PURPOSE: To eliminate need of providing a device with special configuration for separating connecting terminals to be connected with the outside, by forming a monolithic IC sealed section and a connector housing of first and second resins, respectively.

CONSTITUTION: A semiconductor device comprises a monolithic IC sealed section 13 in which a monolithic IC 16 and a part of first and second connecting terminals 113~119 electrically connected to the IC 16 are sealed with a first resin 13a, and a connector housing 14 formed of a second resin 14b to enclose the second connecting terminals 116~119. According to the present method in which formation of the connector housing 4 and sealing of the monolithic IC 13 are performed separately, it is possible to obtain a device not requiring any special configurations for separating the connecting terminals 116~119 connected with the outside.





(54) DEVICE FOR ELIMINATING WIRE-PROPAGATED NOISE FOR VEHICLES

(11) 1-91499 (A)

(43) 11.4.1989 (19) JP

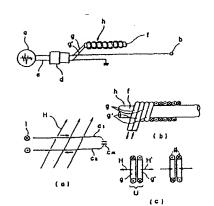
(21) Appl. No. 62-248073 (22) 2.10.1987

(71) YAZAKI CORP (72) MASAAKI TODA

(51) Int. Cl. H05K9/00,B60R16/02,H01B7/00

PURPOSE: To prevent generation of noise adversely affecting to electronic equipments for vehicles, by connecting a noise suppressing line consisting a pair of line wound spirally on a core, with a power supply line of an electric noise source.

CONSTITUTION: A noise suppressing line (h) consisting of a pair of lines (g), (g') wound spirally on a core (f) is connected to a power supply line (b) of an electrical noise source (e.g. electric fuel pump) (a). In the noise suppressing line (h), current flows alternately to opposite directions in view of the cross section of a coil unit U constituted by the pair lines (g), (g'). Accordingly, magnetic fluxes H, H' generated in the coil flow always in opposite directions and act to cancel with each other. Therefore, no electromagnetic wave is leaked out of the device. Electromagnetic radiation from the noise suppressing line (h) is thus eliminated completely, and there is no disturbance to electronic equipments such as generation of radio noise or erroneous operation.



⑩日本目特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

四公開特許公報(A)

平1-91498

@Int_Cl_4	證別記号	厅内整理香号	④公開	平成1年(1989)4月11日
H 05 K 7/02 H 01 L 23/28 23/34 23/48		7373-5F Z-6835-5F B-6835-5F G-7735-5F		
H 01 R 9/16 H 02 P 9/30 H 05 K 5/00	101	6901-5E F-7239-5H B-6412-5F等查請求	未請求	請求項の数 6 (全は頁)

〇発明の名称 樹脂封止型半導体装置およびその製造方法

②特 題 昭63-108520

明 考 母業 \blacksquare 浩 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 一 弱 加 藤 豪. 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電芸株式会社内 绞 ②発 明 者 前 原 冬 掛 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電芸株式会社内 母 明 者 新 蒂 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 亮 ①出 題 人 日本電装株式会社 爱知県刈谷市昭和町1丁目1番地 ⑫代 理 人 弁理士 岡 部

明知書

1. 発明の名称

樹脂封止型半導体装置およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(I) 電気負荷に電気接続する複数の第1の接続端子と、

前記電気負荷外部の装置に電気接続する第2の接続端子と、

源電性を育する部材に搭載すると共に、前記第 1、第2の接続端子に電気接続し、前記電気負荷 の作動を制御するモノリシック ICと、

第1の樹脂により前記モノリシック I Cおよび それと電気接続した前記第1、第2の接続端子の 一部を封止したモノリシック I C 封止部と、

第2の樹脂により前記第2の接続端子を外囲成形したコネクタハウジングと、

を備えることを特徴とする樹脂封止型半導体数 置。 (2)前記第1の樹脂は熱硬化性樹脂から成り、前記第2の樹脂は熱可塑性樹脂から成るものである。 請求項1記載の樹脂封止型半導体装置。

(3)前記第2の掛脂は、前記第1の樹脂より外部に表出した前記第2の接続端子の根元部分を少なくとも覆うように形成されたものである請求項1 又は2記載の樹脂封止型半導体装置。

(4)前記第1の掛脂および前記第2の樹脂の接触面は凹凸形状に加工されたものである請求項3記載の樹脂封止型半導体装置。

(5) 配気負荷に電気接続する複数の第1の接続端子と、

前記電気負荷外部の装置に電気接続し、所定角度に曲げられた第2の接続端子と、

事電性を有する部材に搭載すると共に、前記第 1、第2の接続端子に電気接続し、前記電気負荷 の作動を制御するモノリシック ICと、

熱伝導性の良い材質より成る放熱板と、

第1の樹脂により前記放熱板を前記モノリシック 1 C に近接させた状態にて成形固定すると共に、

前記モノリシック【Cおよび前記第1、第2の接 統備子の一部を討止したモノリシック【C封止部 と、

前記第1の樹脂とは異なる成分の第2の樹脂により、前記第2の接続端子を外囲成形したコネクタハウジングとを備え、

しかも、前記放热板は相対的に前記モノリシック IC に対して前記第2の接続端子を曲げた側に 固定されるものである事を特徴とする樹脂封止型 半導体装置。

(6)少なくとも電気負荷に電気接続する複数の第 1の接続端子と、前記電気負荷外部の装置と電気 接続する第2の接続端子とをその枠部に接続した リードフレームを導電性を有する板材より形成す る工程と、

前記電気負荷の作動を制御するモノリシック! Cを、導電性を有する部材に搭載すると共に、前記モノリシック!Cと前記リードフレームとの電気接続を行う工程と、

電気絶縁性の第1の樹脂により前記導電性を有

一44717号公報等に開示されているように I Cやトランジスタ、チップコンデンサ等を基板 (例えばセラミック基板) 上に実装したハイブリッド I Cをコネクタ付のシールドケースに組付けた後、該ケースを質気負荷に一体搭載していた。しかしながら、このようなハイブリッド構造によると、装置が大型化するばかりか、取付け部品点数も多くなり、工数がかかり信頼性の低下につながる。

ところで、近年小型高集積化のニーズが更に高 まり、電気負荷のコントロール回路が該電気負荷のコントロール回路が該電気 利 を駆動するパワーデバイスと一体化され、モノリシックIC化されている。このモノリシックIC は電気負荷に一体搭載されて、小型、軽量、低ノリ はないのは、このようなモノリシックICを組付けた装置として樹脂封止型半半 ないのでは、部品点数・工数の削減を目的として 外枠に各接統備子を接続したリードフレームを使 用している。

しかしながら、電気負荷として交流発電機等を

する部材に搭載した前記モノリシック I C および 前記第1、第2の接続端子の一部を封止する工程

前記リードフレームの枠部を切り離す工程と、 前記絶縁性の第2の掛脂により前記第2の接続 端子を外囲成形する工程と、

を煽えることを特徴とする樹脂封止型半導体並 、 置の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は樹脂封止型半導体装置およびその製造方法に関し、例えば東西用交流発電機(オルタネータ)等の電圧調整器として用いる (Cレギュレータ (集積型半導体式電圧調整器)に効果的に適用できるものである。

〔従来の技術〕

従来、ICレギュレータについては冥公昭57

想定し、その作動の制御を行おうとする場合、「 Cレギュレータはこの交流発電機内の端子と電気 接続を保ち、信号の授受および電流の駆動等を行 なうと同時に該交流発電機外部との信号の授受お よび電流の駆動等を行う必要がある。即ち、交流 発電機内の接続端子と外部との接続端子を端え、 しかも、外部との接続端子は微級的な衝撃により 曲がらないように保護する必要があり、又、通常、 各端子の入力インピーダンスが高いので訪示構造 にする必要もあることから、樹脂により外囲成形 したコネクタを形成しなければならない。そして、 その為に従来のリードフレームを用いた樹脂封止 型半導体装置における技術をそのまま適用するこ とができず、従来ではリードフレームを用いた樹 脂封止型のICレギュレータを構成したものは存 在しなかった。

本願発明者達はこのような I C レギュレータを 実現すべく、先に特願昭 6 2 - 8 6 8 3 号を提案 したが、実際には外部との接続端子を電気的に分 組した状態にでリードフレームの外枠から切り器

符册平1-91498 (3)

すためにはその接続端子を特殊な形状にしたり、 その接続端子のリードフレームとの切断面が IC レギュレータ外部に表出してしまうという不具合 点があり、一酒の改善が望まれている。

(発明が解決しようとする課題)

そこで本発明は、上記の点に搬みなされたものであって、外部との接続端子を外囲成形したコネクタを有する樹脂封止型半導体装置においてで、外部との接続端子を分離するためにその形状を何ら特殊な形状にする必要のない装置を提供することを第1の目的としており、又、ことを用いて製造することにより部品点数・工数を削減である。 製造方法を提供することを第2の目的としている。

(課題を解決するための手段)

上記第1の目的を達成するために、本発明者の 樹脂封止型半導体装置は、電気負荷に電気接続する複数の第1の接続端子と、

猫子と、

前記電気負荷外部の装置に電気接続し、所定角度に曲げられた第2の接続端子と、

事電性を有する部材に搭載すると共に、前記第 1、第2の接続端子に電気接続し、耐記電気負荷 の作動を制御するモノリシック ICと、

熱伝導性の良い材質より成る放熱板と、

第1の樹脂により前記放然板を前記モノリシック I Cに近接させた状態にて成形固定すると共に、前記モノリシック I C および前記第1、第2 の接続端子の一部を封止したモノリシック I C 封止部と、

前記第1の樹脂とは異なる成分の第2の樹脂により、前記第2の接続端子を外囲成形したコネクタハウジングとを備え、

しかも、刑記放热坂は相対的に刑記モノリシック「Cに対して前記第2の接続端子を曲げた側に 固定されるものである事を特徴としている。

又、上記第2の目的を達成するために、本発明 の樹脂封止型半導体装置の製造方法は、少なくと 前記電気負荷外部の装置に電気接続する第2の 接続端子と、

導質性を有する部材に搭載すると共に、前記第 1、第2の接続端子に電気接続し、前記電気負荷 の作動を制御するモノリシック ICと、

第1の樹脂により前記モノリシック I C および それと電気接続した前記第1、第2の接続端子の 一部を封止したモノリシック I C 封止部と、

第2の掛脂により前記第2の接続端子を外囲成 形したコネクタハウジングと、

を備えることを特徴としている。

前記第1の掛脂は熱硬化性樹脂から成り、前記第2の樹脂は熱可塑性樹脂から成るものであってもよい。

前記第2の掛脂は、前記第1の樹脂より外部に 衰出した前記第2の接続端子の根元部分を少なく とも**項**うように形成されたものであってもよい。

前記第1の樹脂および前記第2の樹脂の接触面は凹凸形状に加工されたものであってもよい。

又、電気負荷に電気接続する複数の第1の接続

も電気負荷に電気接続する複数の第1の接続端子と、前記電気負荷外部の装置と電気接続する第2の接続端子とをその枠部に接続したリードフレームを、導電性を有する板材より形成する工程と、

前記電気負荷の作動を制御するモノリシック「Cを導電性を有する部材に搭載すると共に、前記モノリシック「Cと前記リードフレームとの電気接続を行う工程と、

電気絶縁性の第1の樹脂により前記導電性を有する部材に搭載した前記モノリシック1 Cおよび前記第1、第2の接続端子の一部を封止する工程と、

前記リードフレームの控部を切り離す工程と、 前記絶縁性の第2の掛脂により前記第2の接続 端子を外囲成形する工程と、

を備えることを特徴としている。

(実施好)

以下に本発明を実施例により説明する。 (実施例1) 本発明の実施例1の掛脂封止型半導体装置1の 平面図、裏面図及びA-A線断面図を第1図、第 2図、第3図に示す。

この樹脂封止型半導体装置 1 はコネクタハウジング 1 4 と、該コネクタハウジング 1 4 によりその一部を被覆されたモノリシック 1 C 封止部 1 3 と接続端子群及びヒートシンク(放然板) 1 2 とから構成されている。コネクタハウジング 1 4 は、外部接続端子群の外周を囲んでコネクタを形成すると共に、モノリシック 1 C 封止部 1 3 の主面を一体的に被覆して形成されている。

モノリシック I C 封止部 1 3 は、第 4 図(a) に示すリードフレーム 1 1 の所定箇所に、その裏面図である第 4 図(b) に示すようにモノリシック I C 1 6 を係止し、ワイヤ 1 7 でモノリシック I C 1 6 と各接続端子群とを電気的に接続してリードフレーム 1 1 a を得る。そしてその後、樹脂 1 3 a で封止して形成されている。

リードフレーム I I は板材より打ち抜かれ、枠部及び接続端子群ヒートシンク接続部とを有し、

枠部112には短い連結部112aで連結された ヒートシンク接触部120とからなる。これら内 部接続端子113.114.115、外部接続端 子116.117.118.119及びヒートシ ンク接触部120は、樹脂によりモノリシック封 止部13形成後外枠部111、模枠112上に切 り離されて互いに電気的に独立し、かつそれらの 他端側はボンディングされるモノリシックICI 6 の電極位置と対応するものとなっている。上述 の内部接続端子群113、114、115は本発 明で言うオルタネータ等の電気負荷に電気投続す る第1の接続端子に相当し、外部接続端子群11 6. 117. 118. 119はパッテリ、ECU 等の外部の装置に電気接続する第2の接続端子に 相当する。又、本発明で言う導電性を有する部材 は、本実施例では内部接続端子114に一体的に 形成される。尚、このリードフレーム11はエッ チング等の化学加工等により形成しても良く、又、 半田付性、ワイヤボンディング性等を考慮し、通 常、表面がメッキ処理されている。尚、あらかじ

枠部は樹脂封止型半導体装置形成前に切り離されている。

モノリシック I C 封止 問能 1 3 a とコネクタハウジング 形成 樹脂 1 4 b との接触面はモノリシック I C 封止部 I 3 a が凸状 I 3 1 を形成し、 樹脂 1 4 b と強固に固着している。 外部 嫡子 群の 周囲は空隙 1 4 a を形成し、コネクタ 相手部材のメス部との結合を形成する 様成である。

リードフレーム11は第4図(a)に示すように一 牧の板材、例えば厚さ一定の銅合金板をプレス、 の機械加工により打ち抜いて形成したものでの外 方向に伸びる2本の外枠部111と、これら外して 111と連結する機枠部112を持つ。そりして 2本の外枠部111と談接する2本の 機枠の 2本の外枠部111と談接する2本の機合外外 111には被切断部となる比較的短い連結部11 1 aで連結された3個の内部接続端子群113、 114、115と、他方の外枠部111の外部 第一1115を介して連結された4個の外部 第子群116、117、118、119、及び模

めメッキが施されたメッキ材を使用しても良い。

そして、第4図(0)に示すように上記リードフレ ーム11の所定位置にモノリシックIC16を半 田付等により固定した後、各接統端子の他端側と モノリシックICI6上に設けられた所定の電極 との間をワイヤーでワイヤボンディングする。 ついで樹脂 l 3 a によりモノリシック l C l 6 及 びそれと電気接続した内部接続端子群113.1 14.115、外部接続端子群116.117. 118.119の一部を封止してモノリシック1 C封止部13を形成する。即ち第1の成形金型に、 アルミニウムあるいは顕築の熱伝導率の良好な金 **属製ヒートシンク12を固定し、ついでモノリシ** ック!C16を保止したリードフレーム!!aを 固定して型締を行う。ここでヒートシンク12は 第6図及び第7図に示すように各短片側より突出 した固定用の貫通孔し21を有する長方形で突出 部の片方には段差し22が設けてある。この段差 122を利用してリードフレーム11のヒートシ ンク接触部120とだけヒートシンク12が接触

するように成形会型に固定してあるので、樹脂成形後所定の部位を切り落とした後はヒートシンク12はヒートシンク接触部120を除くすべての接続端子と電気的に独立している。

型婦が後に所定の樹脂13aを第1の成形金型 のキャビティに注入し、園化せしめて第5図ににす すモノリシック【C封止部13を有するリードフレーム1aを得る。ついでこのリードフレーム1 aを得る。ついでこのリードフレーム1 aを得る。ついでは明明する。即ち各内部接続端子116。111 aとの境界部と各外部接続端子116。117。118、119とタイパー111bとの境界部と切断する。各外部接続端子116、117、118、119の各先端部115a、117a、118、119の各先端部115a、117a、118、119の各先端部115a、117a、118、119aを第10図に示すように板厚方向にテーパ状につる。 板板内の両属を面取りした形状とする。 板格方向の両属を面取りした形状とする。 た成形体を第1成形体1bとする。

このモノリシックIC封止部13の樹脂13a

スに蓋をする工程等が不要となり、又、製品の多 数個取りができるので部品点数・工数が削減でき る。又、コネクタハウジングの成形と、モノリシ ックICの封止とを個別に実施する事により、リ ードフレームの切り離しが容易にかつ確実に行え る。又、モノリシック! C 封止後にリードフレー ムの枠部切り難しコネクタハウジングの成形を行 い、しかも樹脂14bは外部接続端子116、1 17.118.119の祖元部分をも封止してい るので、リードフレームの切り離し時に発生する 耐温性の低下が防がれる利点がある。 さらに、1 Cの封止に用いる樹脂I3aと、コネクタハウジ ングの外囲成形に用いる樹脂し4bとを別種のも のとすることも出来る。例えば樹脂 1 3 a を引湿 性、耐応力性、成形性に優れた熱硬化性樹脂のエ ポキシ樹脂を用い、樹脂 1.4 b には破壊強度、寸 法安定性に優れる熱可塑性樹脂のPBT(ポリブ チレンテレフタレート)、PPS (ポリフェニレ ンスルヒド)、66-ナイロン等を用いると、計 湿性、耐応力性と同時に機械強度、可法安定性に

て第1図、第2図、第3図に示す樹脂封止型半導体装置1を得る。尚、樹脂14bは外部接続端子116,117,118,119を外囲成形すると共に、第1図および第3図に示すように、それら外部接続端子の根元部分を樹脂封止して耐湿性

とコネクタ形成樹脂14もとが接触する面には第

8図、第9図の131に示すように凸状部を設け

ることにより、暗み付き性を高めて接触面を強固

ついで第1成形体1bを第2の成形金型に固定

し、型締めして、所定の樹脂146で外囲成形し

に固若させる.

17. 118. 119の各先端部116a. 117a. 118a. 119 aはコネクタ形成制脂14bの空隙(凹部)14a内に配置するように形

を向上させている。又、外部接続端子116.1

成されている。

本実施例の掛脂封止型半導体装置 1 は上述のようにリードフレームを用いて製造でき、従来のハイブリッド構造の装置の製造において必要である 各々の接続端子をセットする工程やシールドケー

優れた半導体パッケージとなる。

また、上述のように熱硬化性樹脂と熱可塑性樹脂とを使用すると両樹脂間には接着力がないので、例えば耐湿性等が劣ることになるが、モノリシック「C封止部13に凸部131を設けて樹脂14 b との形すると樹脂13 a と樹脂14 b との密着力が向上する。そして、このように両樹脂13 a . i 4 b の接触面の密着力を向上することにより、樹脂界面からの湿気の浸入を耐き、耐湿性をわりに対距界面からの湿気の浸入を耐き、耐湿性をわりに大け、

また、モノリシックIC封止部13形成後に外枠部111、機枠部112、連結部111a、112a、グイバー111bを切り離すが、この切り超し部分はモノリシックIC封止部13の外砂になるように配設されており、切り超し工程の祭には、ワイヤボンディング部が完全に樹脂封止されているのでワイヤボンディングには悪影響を及ぼさない。従って本発明の樹脂封止型半導体装置

ICHELL

23-55-184

は耐湿性、腹膜強度に優れている。

また、外部接続端子(16.117.118.119の各先端部(16a.117a.118a.119の各先端部(16a.117a.118a.119aはコネクタ形成樹脂(4bの空線(4a内に配置するように形成されているので、コネクタ祖手部材の結合前にその先端部(16a,117a.118a.118a.119aが他の装置と接触してしまうとか、コネクタ祖手部材のメス部と反対向きに結合してしまうとかいった不具合がなくなる。(実施例2)

本実施例で形成する制脂封止型半導体装置は実施例しと同じであるが、使用するリードフレームの構造を異にするものである。

すなわち本実施例2のリードフレームを第12 図に示す。このリードフレーム21は外部接続端子野216、217、218、219が外枠部2 11には連結されておらず、4本のうちの外側にある2本の外部接続端子216、219は損枠部212に伸びる比較的長い連結部212bに連結されており、そして残りの内側の2本の外部接続

型半導体装置が得られる。

この樹脂封止型半導体装置は、リードフレーム 21の外部接続端子216,217,218,2 19の各先端部216a, 217a, 218a, 2 1 9 a があらかじめ実施例1 のように加工され ているため、モノリシック(Cを封止した後の先 端部を加工する必要がないので加工歩留りを上げ る事ができる。即ち、半製品化後の後加工よりも 素材段階での加工の方が加工不良発生に対するコ スト面で有利さをもっているためである。また、 モノリシックIC封止後に切り取られる連結部で、 外部接続端子2 16. 219から各模枠部212 に伸びた比較的長い連結部212b及び各外部接 統端子217.218に隣接する外部接続端子間 を連結する中継部25は、第2の成形により掛脂 に覆われる箇所に配設されているので、外部接続 端子216、217、218、219が樹脂より 群出している部分には速結部2 1 2 b 及び中継部 25の切断時の切り残し、ばり等が全くない。し たがって、外部コネクタ (図示せず)を嵌合させ

描子217、213は、それぞれ隣接する外部接続描子に中継部25を介して連結されている。ここで連結部2120及び中継部25は、モノリシックIC封止部23形成後、問間23aの外部に配設し、かつ後工程のコネクタの成形により第2の問題で覆われる箇所に配設される。さらに各外部接続描子216、217、218、219の先端部216a、217a、218a、219の先端部216a、217a、218a、219aは、第10図及び第11図に示す形状にあらかじめ形成されたリードフレームである点が実施列1と異なる。

第12図に示すように、このリードフレーム21を実施例1と同様にモノリシック 1 C 2 6 を係止し、ワイヤ27でワイヤボンディングした後、ヒートシンク22と共に樹脂23aでモノリシック 1 C を封止する。得られたモノリシック 1 C が出まるリードフレーム2 a を第13図に示す。以下、実施例1と同様にリードフレーグを樹脂で外囲成形すると実施例1と同じ樹脂封生

た時に外部コネクタ内の接続端子との引っ掛かりがなく滑らかに摺動する。

(実施勞3)

実施例3は第14図、第15図に示すリードフレーム31を用いる他は実施例1と同様である。このリードフレーム31は第15図に示す側面図のように肉厚が異なった厚肉部31aと薄肉部31bとを持つ異形断面の調合金板を打ち抜いて作ったものである。

リードフレーム 3 1 は第 1 4 図に示すように 左 側の外枠部 3 1 1、 機枠部 3 1 2 の 左側部分、 3 個の内部接続端子 3 1 3 . 3 1 4 . 3 1 5 、 ヒートシンク接触部 3 2 0 及び 4 個の外部接続端子 3 1 6 . 3 1 7 . 3 1 8 . 3 1 9 とモノリシック 1 C 3 6 とをワイヤ 3 7 にてワイヤボンディング する 箇所を 厚肉部とし、これら 4 個の外部接続端子 3 1 6 . 3 1 7 . 3 1 8 . 3 1 9 の他の部分、 右 側の外枠 3 1 1 及び 機枠部 3 1 2 の右側部分を 1 肉部としたものである。

上記のリードフレーム31を用いて得られる岩

脂封止型半導体装置は内部接続端子313.31 4.315が樹脂封止型半導体装置を内蔵する電気負荷自身が発生させる援動や外部から受ける撮動により応力がかかるが、肉厚を厚くした分だけ応力が緩和され折損する事がない。

又、パワーデバイスがスイッチング時等に発生する 過渡熱を放散するという利点を有する。なお、耐応力高強割れ性等を考慮して網合金材料を進定し、厚肉部 3 1 a の板厚を例えば1 mm以上とすれば、少なくとも M 4 のネジ山を 3 ピッチ分環保できる様なパーリング加工を施すことも可能であり、相手方の端子との接続が容易となる。

(実施列4)

本実施例の樹脂封止型半導体装置4の平面図及び裏面図を第16図、第17図に示し、第17図のB-B線断面図を第18図に示す。この樹脂封止型半導体装置4は、外部接続端子群を90°折り曲げコネクタが内部接続端子に対し直角方向に間口しているものである。ここで用いるリードフレームの裏面図を第19図に示す。このリードフ

接触部420等からなる。このリードフレーム411は実施例2で使用のリードフレーム21と1413、417a、418。417a、418。417a、418。419。各先端部418。417。418。419。は第10図及び第11図におびかり、又中継部45を持っ、417、418、417、418、417、418、417、418、19の引出し方向を樹脂封止型半球は多一ンともののが表が大きの間があため、外部接続端子416、417、418、419の同辺の形状が大きのでかっているため、外部接続端子416、417、418、419の同辺の形状が大きと機枠部をしていたが、大きに伴い外部接続端子とし機枠部をしていた。又、それに伴い外部接続端子と機枠部が変わっていた。

第18図、第24図に示すように、モノリシック!C封止部43に設けたテーパ部432は、第18図に示すようにコネクタハウジング樹脂44 bによる第2成形での逃げ部442を形成するために設けたテーパである。逃げ部442は外部コネクタ(図示せず)がスカートを有する場合、ス

リードフレーム41は厚さ一定の網合金板を打ち抜いて形成したもので、第19図に示すように外枠部411、横枠部412、3個の内部接続端子413、414、415、4本の外部接続端子416、417、418、419、ヒートシンク

カートとコポクタハウジング44とが干渉しない ようにしたものである。本来なら前記干渉を選け るためには、単純にコネクタハウジング44を発 1成形の問題43aより選ぎければ良いが、軽では 中に、大型化という観点から見れば、この方法は 中に大きを伸ばすだけでありが記さしくない。 中に大きを伸ばすだけでありができる。又では で、実施例4のようにテーパができる。又では 6図、第17図に示す肉盗み部441が2箇所 り、外部接続端子416.417.418.41 9を同一ドフレームパクーンが既にないたが、 の穴のるいは貫通穴となって肉盗みを行ったもの である。

これにより材料節被、軽量化、コストグウンをはかったものである。

実施例1.2.3のようにコネクタの方向を取付方向に平行なものでは実現が難しいコネクタ配列が可能となること、又、頃1列配置に比して占有面積が少なくてすむ利点を有する。

本発明のように一体搭数される樹脂封止型半導体装置に於いては、占有面積を少なくする方が小型化を目指す電気負荷としておさまりが良い。 (実施例5)

本実施例は、電気負荷としてのオルタネータに 接続される I C レギュレータをより具体的に説明 するものである。この I C レギュレータ 5 の斜視 図を第31図に示す。この I C レギュレータ 5 は 上記実施例 4 と同様に外部接続端子群を90 が り曲げ、コネクタが内部接続端子に対し直角方向 に開口しているものであるが、その曲げ方向が実 に開口しているものであるが、その曲げ方向である。 施例 4 とは異なり、モノリシック I C に対してヒートシンク 5 2 側に曲げたものである。

本実施例の製造工程を第25図~第31図を用いて説明する。まず、ここで用いるリードフレームの平面図を第25図に示す。このリードフレーム51は内部接続端子513、514、515、520及び外部接続端子516、517、518、519をその外枠511及び機枠512に接続し、さらに、内部接続端子514、520、外部接続

2 7 図はヒートシンク 5 2 が裏面に固定された図を示しており、又、樹脂 5 3 a に形成された凸状 5 3 1 は後述する樹脂 5 4 b との密着力を向上するためのものである。

ついで外枠511、模枠512、各連結部を切り組して第29図にその裏面図を示す第1の成形体5bを得る。ここで、アイランド部520a時に内部接続端子513との接続端513とも同時に切断している。さらに、外部接続端子516、517、518、519の引出し方面を1Cレギュレータ5の取付面、即ち樹脂53aの成す平面のに対して略直角に折り曲げて第30図の料面のに示すような第2の成形体5cを得る。そして最近に示すような第2の成形体5cを得る。そして最近に、PBT等のコネクタハウジング用樹脂54bで外囲成形を実施し、第31図の料視図に示すしてレギュレーク5を得る。

このようにして形成される I C レギュレータ 5 は第 3 2 図の平面図に示すように内部接続端子 5 I 3 . 5 I 4 . 5 I 5 . 5 2 0 を介してオルタネータ 6 に組み付けられる。第 3 2 図はオルタネー

端子519の一端には後述するモノリシック【C 56a,56b,56cが搭載することになったるではないではまることになった。 519aが新設 514a.520a,519aが部分ではないでは、アイランド520aは内部にはないでは、下の部接続はでれた。 あいまればはないでは、大力部には、大力を出する。 514bが開始をは、アイカンの密着力を増かられている。 514bが開始を表現している。 514bが開けられている。 518b,519bが開けられている。

ついで、第26図に示すようにモノリシック I C 56a. 56b. 56cをそれぞれアィランド 部514a. 520a. 519aに半田付等により 係止する。そしてワイヤ57にてワイヤボンディングした後、第28図に示す形状のヒートシンク 52と共に、エポキシ樹脂から成る樹脂 53aにてモノリシック I C 封止体 5aを得る。尚、第

タ 6 のリアカバーを外した状態でリア側を部分的に示した図であり、6 1 は8個のダイオード 6 3 より構成されたレクティファイア、6 2 はブラシホルダを示しており、又、1 C レギュレータ 5 はネジにより組み付けられ、オルタネータ 6 と電気接続している。

ICレギュレータ5は、B端子より制御回路で Oに入力するオルタネータ6の発電電圧、及びS 端子より入力するバッテリ 電圧の各信号に基づい てトランジスタフィをON-OFF副御して、オ ルタネータ6の発電を制御する。又、オルタネー タ5の一相出力電圧Ⅴ。をP端子より入力して、 その電圧 V゚が所定電圧 V゚より大きくなった時に は信号線a、bにそれぞれし(ロー)レベルの信号 を出力する。従ってトランジスク72、73はそ れぞれON、OFF状態となり、バッテリ83か らの電流が、IG端子、トランジスタ72、L端 子を介して負荷82に流れるようになる。逆に、 電圧ⅤΦが所定電圧Ⅴ基より小さくなった時には、 信号線a, bにそれぞれH(ハイ)レベルの信号を 出力する。従ってトランジスタ72、73は、そ れぞれOFF、ON状態となり、バッテリ33か らの電流がチャージランプ81、L端子、トラン ジスタ73を介して流れ、その結果、チャージラ ンプ81が点灯する。又、トランジスタ71の0 N-OFF状態がオルタネータ6の発電状態に密

接に係わりあっているので、この信号を制御回路 70を介してFR端子に導いており、この信号を、 例えば車両制御のECU等に供することもできる。 尚、この図において端子B、F、E、Pは内部接 統端子514、515、520、513に対応し、 端子S、IC、L、FRは外部接統端子517、 518、519、516に対応している。又、E 端子は接地されており、B端子はオルタネータ6 の発電電圧をバッテリ83に供給する端子である。

子のようなそれが無視できない端子は、入力イン ピーダンスを低く設定することにより、リーク 捕 償を行っている。

そこで本実施例5によると、上記実施例4と同 操に部品点数・工数を削減し、より小型のICレ ギュレータを提供できるものであるが、さらに本 実施例によると、外部接続端子516,517. 5 1 8, 5 1 9 の引出し方向をヒートシンク5 2 側に折り曲げているので、何ら放熱性を悪化させ ることなく、第34図の側面図に示すようにヒー トシンク52とは反対側において樹脂53aと樹 脂54bの接着面積を大きくできる。樹脂54b により形成されているコネクタハウジングにメス 型のコネクタ相手部材を差し込む場合には、図中 に矢印Pで示すような押圧力が働くが、この力は 樹脂546が折れ曲がった部分(を支点として、 樹脂53aの下部に接着した樹脂54cが樹脂5 3 a に圧接するような力 P L として作用するよう になり、掛脂53コと樹脂54bとの接着におけ る信頼性を向上することができる。

以上、本発明は上実施例 L ~ 5 を用いて説明したが、本発明はそれらに限定されることなく、その主旨から逸脱しない限り、例えば以下に示す如く種々変形可能である。

①外部接続端子及び内部接続端子と、モノリシックICを搭載する導電性の部材は、一体的でなく別部材であっても良い。

②実施例5のように、複数の外部接続端子を介してチャージランプ81、負荷32等の制御を行う必要のない時は、例えばバッテリ電圧を入力する少なくとも1つの端子(S端子)を顕えれば良い。逆に、実施例5に示す外部接続端子の他に、さらに信号の入出力が必要な時は5端子以上の防水コネククとすればよい。

③本発明の掲點封止型半導体装置を実施對5の ように【Cレギュレータとして構成する場合、制 御すべき電気負荷としてはオルタネータの他に直 波発電数(ダイナモ)であっても良い。

④樹脂封止型半導体装置の製造方法としては、 上記実施例のようにモノリシック (C封止部形成 一枠部切り難し→コネクタハウジング形成の順に 限定されることなく、コネクタハウジング形成→ 枠部切り離し→モノリシック I C 封止部形成の順 であっても良く、その場合にはコネクタハウジン グ形成はその成形後に外部接続端子、内部接続端 子及びモノリシック I C を搭載する部材が固定されるようにする必要がある。

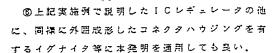
⑤モノリシックICを封止する制器とコネクタックICを封止する機器は、上述のよばフィラーとを形成する機器の他に、例えばフィラーとしてその溶融粘度を著しく上げる事がないラーを入れたPPSとガラス被維等のフもくの形を入れたPPSはからをかけるがあってもとがある。このであれば良いを形成である。というである。というである。というである。というである。というである。というである。というである。というである。というである。というである。というである。というである。というでもはない。

請求項5によると、第1の樹脂と第2の樹脂の 密着性をさらに信頼性の高いものにすることができる。

請求項 6 によると、樹脂封止型半導体装置をリードフレームを用いて形成しているので、部品点数・工数の削減を達成でき、さらにモノリシックしてを封止する工程と第 2 の接続端子を外囲成形する工程とを分けることにより、リードフレームから枠部を容易に切り離ずことができ、リードフレームの加工の自由度を大きくすることができる。又、各々の成形に用いる樹脂を適宜選択することができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図は実施例1の制脂封止型半導体装置平面図、裏面図及び断面図であり、第4図(a)は実施例1のリードフレームを表す平面図、第4図(b)はそのリードフレームにモノリシック1 Cが保止された状態の裏面図、第5図は実施例1のモノリシック1 C封止部を形成したリードフレーム



(発明の効果)

以上述べたように本発明の請求項1にによると、モノリシック「C封止部とコネクタハウジ 講成できるので、従来問題となっていた第2の接続法でするので、従来問題となっていた第2の接続法でするので、従来問題となっていた第2の接続にするので、での構成によりリードフレームを使用可能となるので、部品点数・工数の削減にを使用可能となるので、部品点数・工数のできるのではある。このに、各々の間脂をその要求される機能に応じて適宜選択することができる。

請求項2によると、各々の樹脂のメリットが発揮された樹脂成形品とすることができる。

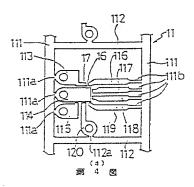
請求項3によると、耐湿性を向上することができる。

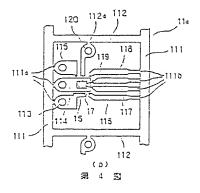
請求項4によると、第1の樹脂と第2の樹脂の 密着力を強めることができる。

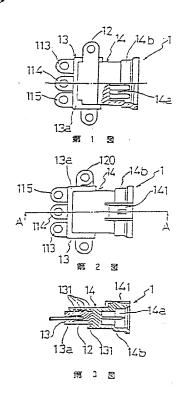
の平面図、第6図はヒートシンクの平面図、第7 図はヒートシンクの側面図、第8図、第9図は実 施例1のモノリシック【C封止部形成後枠部を切 り離したものの平面図及び裏面図であり、第10 図は外部接続端子先端部の加工部の平面図であり、 第11図は第10図の側面図であり、第12図は 実施例2のリードフレームにモノリシックICが 係止された状態の裏面図で、第13図は実施例2 のモノサシックIC封止部形成したリードフレー ムの平面図、第14図は実施例3のリードフレー ムにモノリシックICが保止された状態の裏面図、 第15図は第14図の側面図であり、第16図、 第17図は実施例4の樹脂封止型半導体装置の平 面図で、第18図は第17図の側面図で、第19 図は実施例4のリードフレームにモノリシックし Cが係止された状態の裏面図で、第20図は第1 9図のリードフレームにモノリシック1 C封止部 を形成した平面図で、第21図、第22図は第2 0 図のリードフレームの枠部を切り組したものの 平面図及び裏面図であり、第23図は第21図の

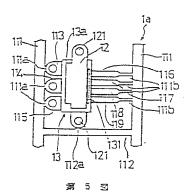
外部接続端子を曲げたものの平面図であり、第2 4 図は第23 図の側面図であり、第25 図は実施 列5のリードフレームの平面図で、第26図は実 **施例るのリードフレームにモノリシックICが係** 止された状態の平面図で、第27回は第26図の リードフレームにモノリシック「C封止部を形成 した平面図で、第28図はヒートシンクの平面図、 第29図は第28図のリードフレームの枠部及び 連結部等を切り離したものの真面図で、第30図 は第29図の外部接続端子を折り曲げたものの斜 視図で、第31図は実施例5の1Cレギュレータ の斜視図で、第32図の実施例5の1Cレギュレ ータをオルタネータに狙み付けた状態を表す平面 図で、第33図は実施例5の1Cレギュレータと オルタネータの電気回路図で、第34図は実施例 5の10レギュレータの側面図である。

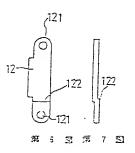
1. 4 … 樹脂封止型半導体装置. 5 … I C レギュレータ. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1 … リードフレーム. 1 3. 2 3. 4 3 … モノリシック I C 封止部. 1 4. 4 4 … コネクタハウジング.

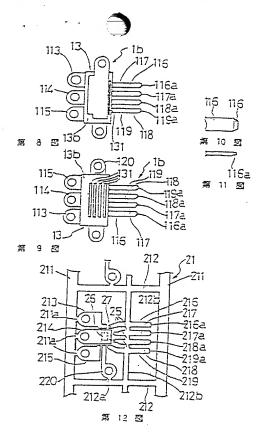


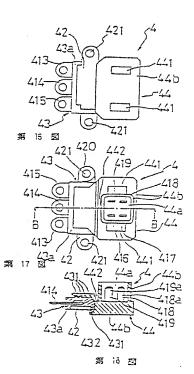


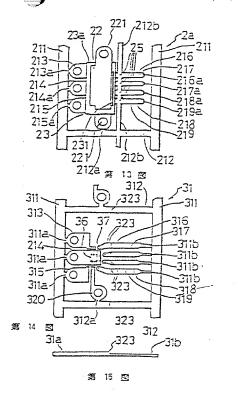


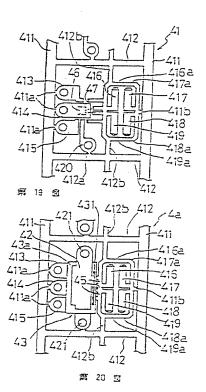


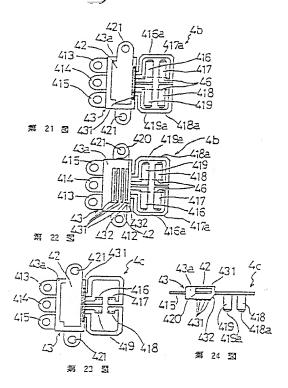


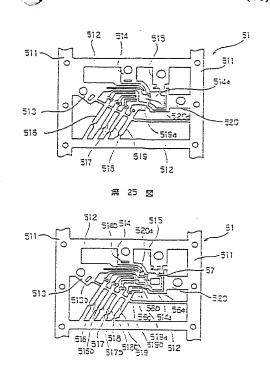




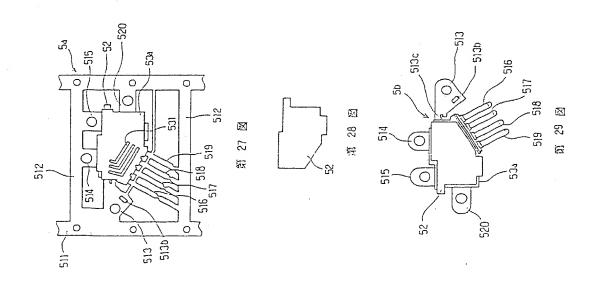


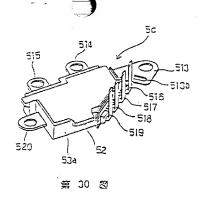


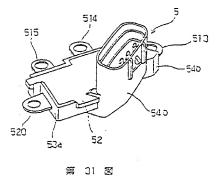


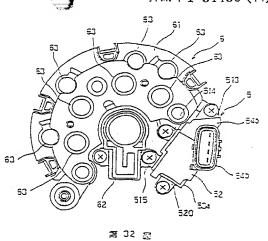


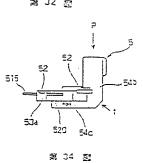
煮 25 翌

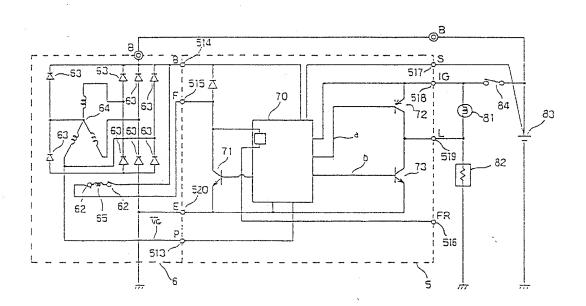












第 33 図